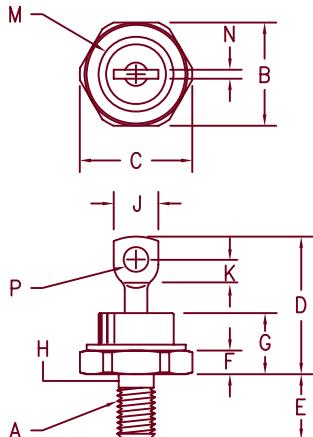


40 Amp Schottky Rectifier

1N5832 — 1N5834



Notes:

1. Full threads within 2 1/2 threads
2. Stud is Cathode.

Dim.	Inches		Millimeter		Notes
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
A	---	---	---	---	1,2
B	.669	.687	16.99	17.45	
C	---	.794	---	20.17	
D	---	1.00	---	25.40	
E	.422	.453	10.72	11.51	
F	.115	.200	2.92	5.08	
G	---	.450	---	11.43	
H	.220	.249	5.59	6.32	1
J	---	.375	---	9.52	
K	.156	---	3.96	---	
M	---	.515	---	13.08	Dia
N	---	.080	---	2.03	
P	.140	.175	3.56	4.44	Dia

DO-213AB (DO-5)

Microsemi Catalog Number	Working Reverse Voltage	Peak Reverse Voltage	Repetitive Peak Reverse Voltage	Repetitive Peak Reverse Voltage
1N5832	20V	20V	24V	
1N5833	30V	30V	36V	
1N5834	40V	40V	48V	

- Schottky Barrier Rectifier
- Guard Ring Protection
- Low Forward Voltage
- 40 Amperes
- 125°C Junction Temperature
- V_{RRM} 20 to 40 Volts

Electrical Characteristics

	1N5832	1N5833	1N5834	
Average forward current	$I_{F(A)}$	40A	40A	40A
Maximum surge current	I_{FSM}	800A	800A	800A
Max peak forward voltage	V_{FM}	.360V	.370V	.380V
Max peak forward voltage	V_{FM}	.520V	.550V	.590V
Max peak forward voltage	V_{FM}	.980V	1.080V	1.180V
Max peak reverse current	I_{RM}	150mA	150mA	150mA
Max peak reverse current	I_{RM}	20mA	20mA	20mA
Typical junction capacitance	C_J	2200pF	2200pF	2200pF
				$T_C = 100^\circ\text{C}$, half sine wave, $R_{\theta JC} = 1.0^\circ\text{C}/\text{W}$
				8.3ms, half sine, $T_J = 125^\circ\text{C}$
				$ FM = 10\text{A}, TJ = 25^\circ\text{C}^*$
				$ FM = 40\text{A}, TJ = 25^\circ\text{C}^*$
				$ FM = 125\text{A}, TJ = 25^\circ\text{C}^*$
				$V_{RRM}, TJ = 100^\circ\text{C}$
				$V_{RRM}, TJ = 25^\circ\text{C}^*$
				$T_J = 25^\circ\text{C}, VR = 5\text{V}$

*Pulse test: Pulse width 300 μsec , Duty cycle 2%

Thermal and Mechanical Characteristics

Storage temp range	T_{STG}	-65°C to 175°C
Operating junction temp range	T_J	-65°C to 125°C
Max thermal resistance	$R_{\theta JC}$	$1.0^\circ\text{C}/\text{W}$ junction to Case
Max mounting torque		30 inch pounds maximum
Typical Weight		.54 ounces (15.3 grams) typical

1N5832 - 1N5834

Figure 1
Typical Forward Characteristics

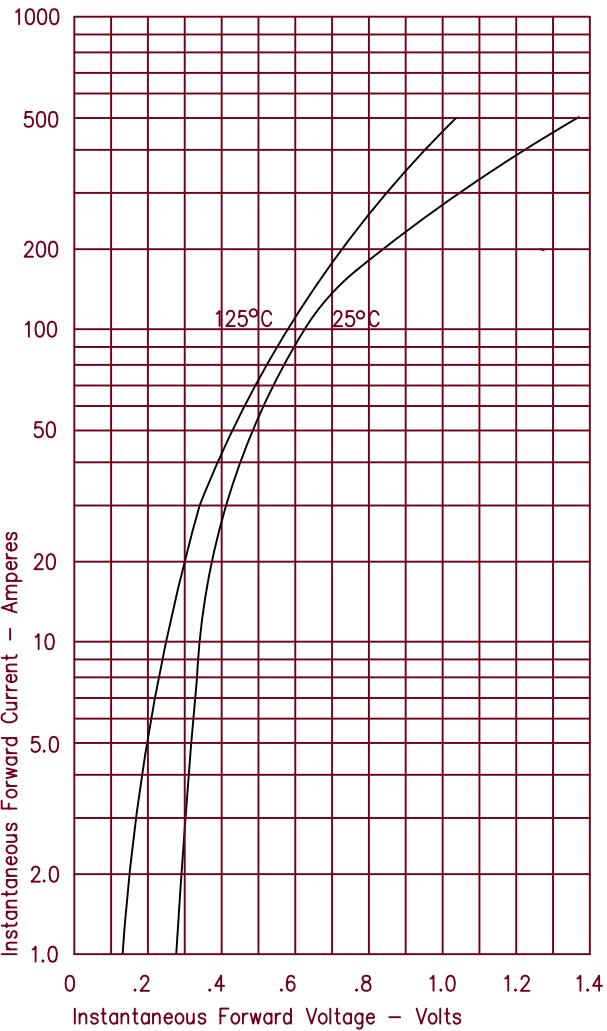


Figure 2
Typical Reverse Characteristics

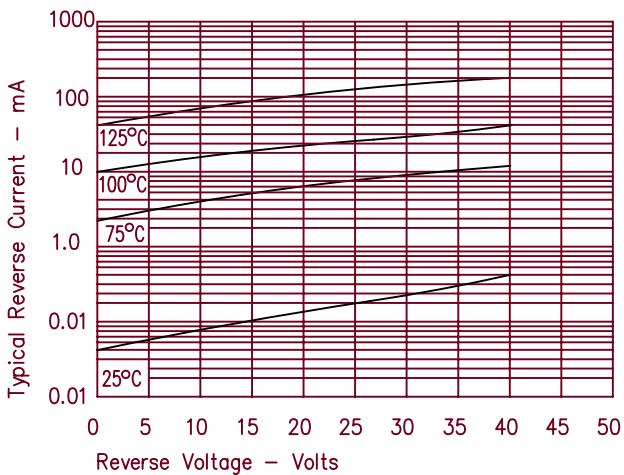


Figure 3
Typical Junction Capacitance

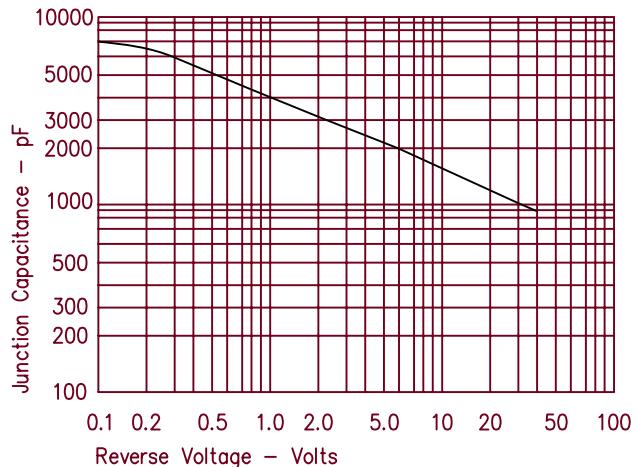


Figure 4
Forward Current Derating

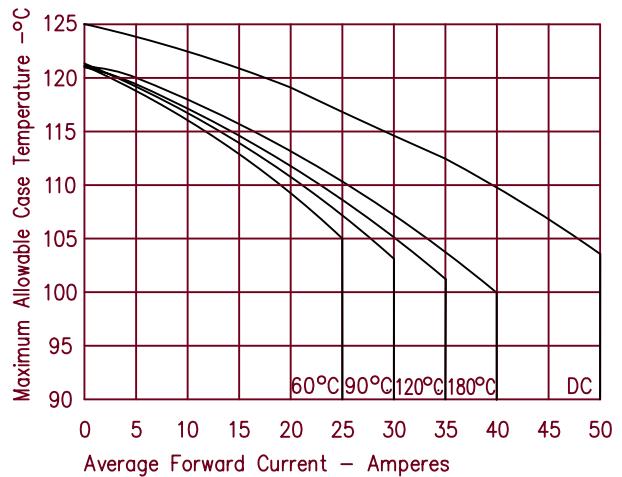
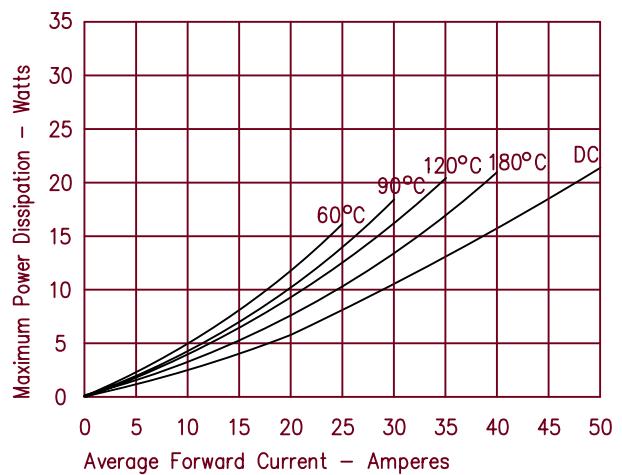


Figure 5
Maximum Forward Power Dissipation





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.